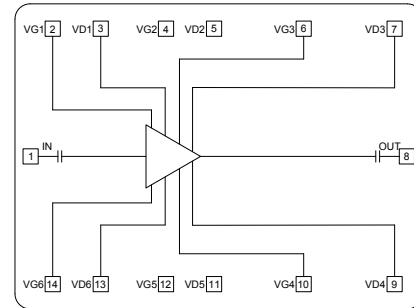


特点：

- 频率：6~18GHz
- 增益：23dB
- 输出 P-1dB：+33dBm
- 工作电压电流：+8V@1.15A
- 工作温度：-55~+85℃
- 芯片尺寸：4.68×2.84×0.1mm

功能框图



性能参数：(TA=+25℃，VD=+8V，VG=-0.67V，ID=1.15A)

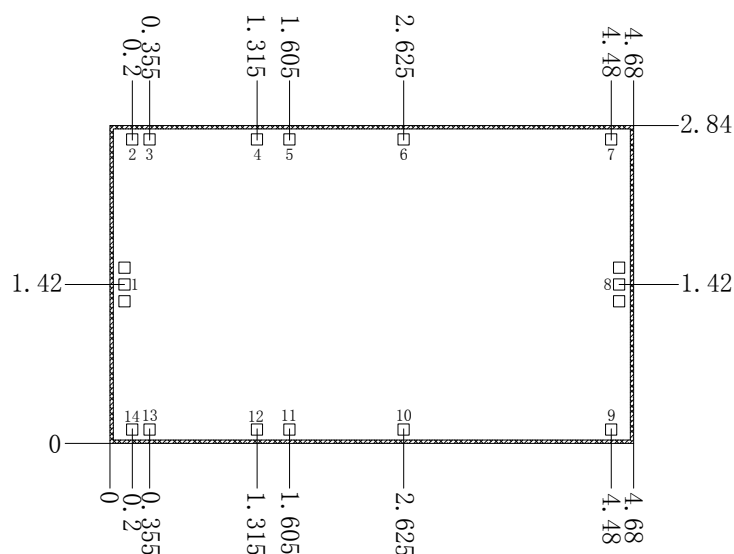
参数名称	符号	测试条件	参数值			单位	备注
			MIN	TYP	MAX		
频率范围	f	VD=+8.0V Zin=Zout=50Ω	6		18	GHz	
增益	G		22	23		dB	
输出功率	Psat		34	35		dBm	
输入驻波	VSWRi			1.5	3		
输出驻波	VSWRo			1.5	3		
输出 P-1	P-1		31	33		dBm	
电压	VD	VD=+8.0V	7.75	8	8.25	V	
电流	ID			1.15	1.5	A	

极限参数表：

参数名称	极限值	单位	参数名称	极限值	单位
最大输入电压	+9	V	最大输入功率	+16	dBm
贮存温度	-55~+150	℃			

芯片尺寸图：

单位：mm

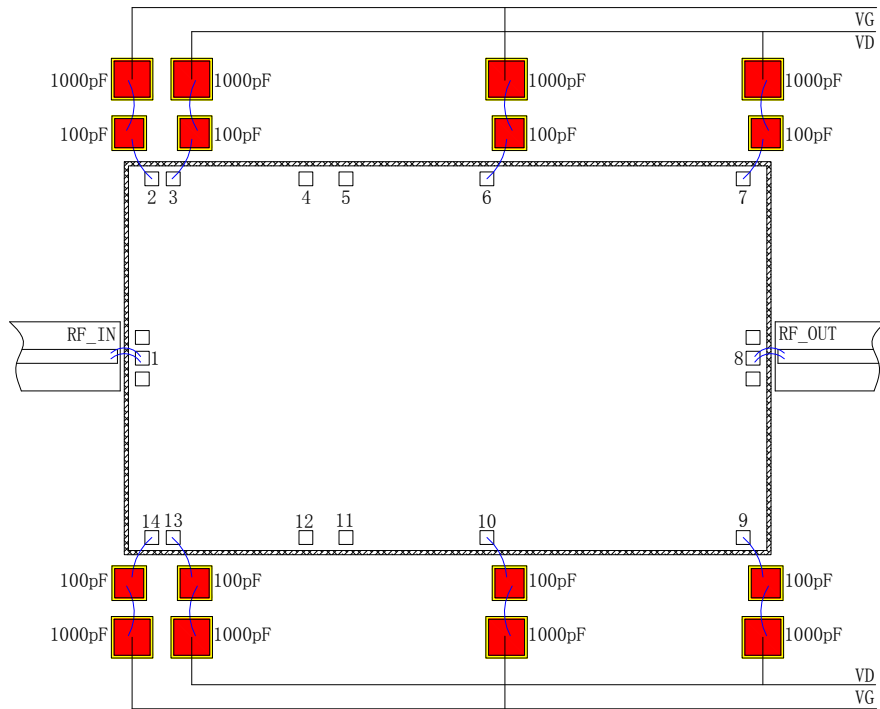


注：典型键合焊盘尺寸为 100*100um

引脚定义：

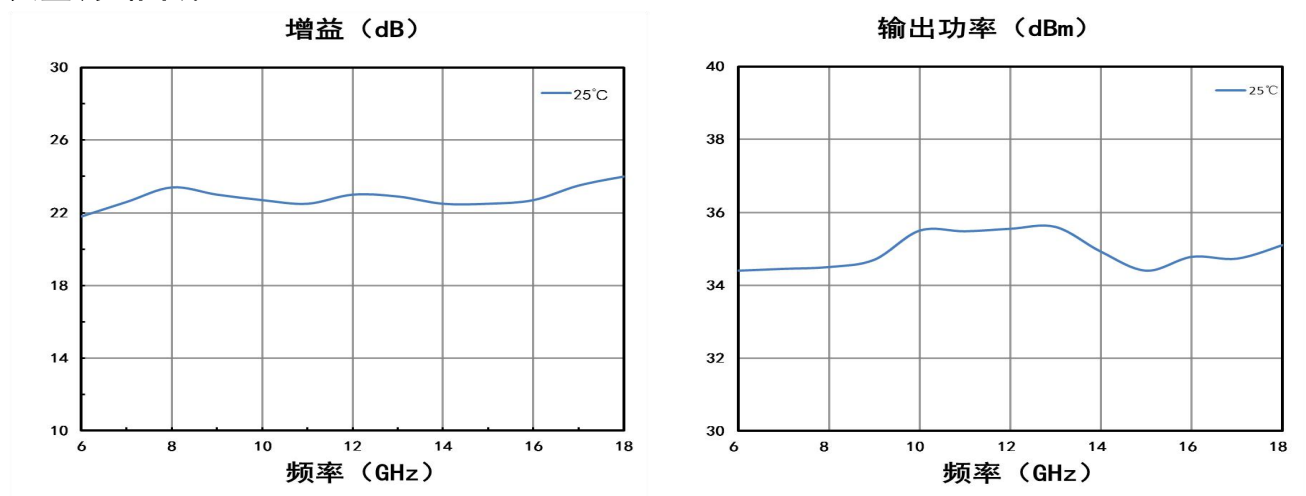
引脚	定义	描述
1	IN	射频输入，AC 耦合
2, 4, 6, 10, 12, 14	VG	放大器栅极电压，需外接 100pF 和 1000pF 旁路电容
3, 5, 7, 9, 11, 13	VD	放大器电源电压，需外接 100pF 和 1000pF 旁路电容
8	OUT	射频输出，AC 耦合
芯片背面	GND	芯片背面必须接至 RF/DC 地

推荐装配图：

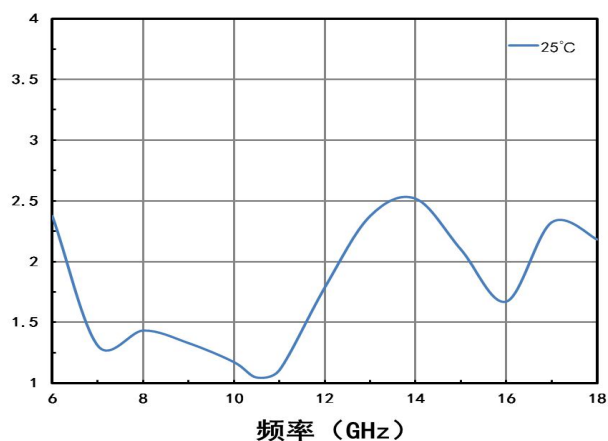


注：未标注的键合焊盘不需要连接

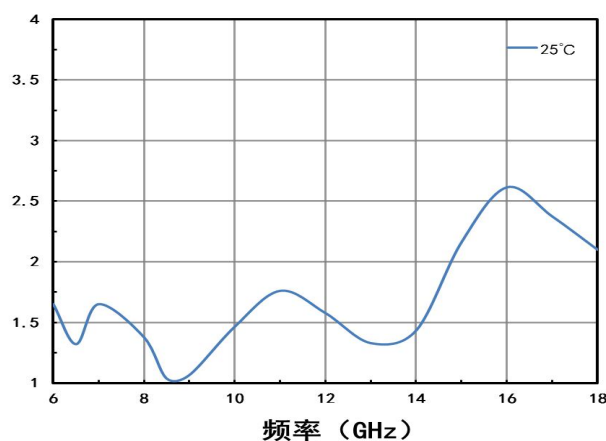
典型测试曲线：



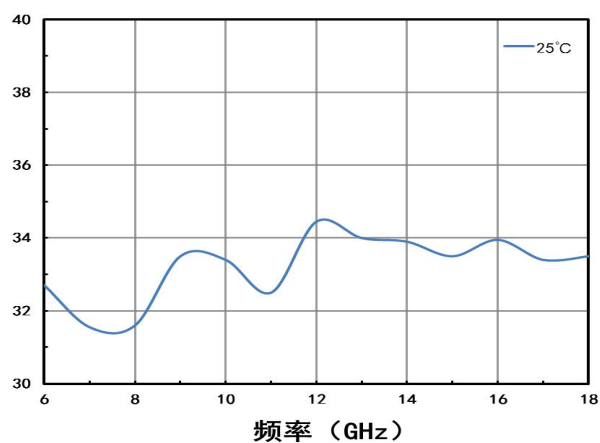
输入驻波比



输出驻波比



输出P-1dB (dBm)



产品使用注意事项:

1. 本芯片产品需要在干燥、氮气环境中存储，在超净环境装配使用；
2. 裸芯片使用的 GaAs 材料较脆，芯片表面容易受损，不能用干或湿化学方法清洁芯片表面使用时必须小心；
3. 芯片底部用导电胶或合金烧结（合金温度不能超过 295℃，时间不能超过 30 秒），使之充分接地；
4. 芯片微波端口与微带线间歇不超过 3 mil，使用 1 mil 双金丝键合，其他端口使用 1 mil 单金丝，建议金丝长度 10~16 mil；
5. 产品对静电敏感，在存储和使用过程中注意防静电；
6. 其他使用说明详见《裸芯片产品使用说明》。